

# Support De Wafer En Ptfé Personnalisé Panier Fleuri

## Conception De Poignée De Nettoyage Semi-Conducteur Résistant Aux Produits Chimiques

Numéro d'article: PL-CP166



### Introduction

Maximisez le rendement des semi-conducteurs avec des supports de wafer en PTFE personnalisés et des paniers fleuris. Conçus pour une résistance supérieure à l'acide fluorhydrique et aux réactifs agressifs, ces systèmes de manipulation de haute pureté sont dotés de poignées ergonomiques et de fentes usinées avec précision par CNC pour un nettoyage sans contamination dans les procédés humides.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Procédés de nettoyage RCA	Nettoyage séquentiel utilisant des solutions SC-1 et SC-2 pour éliminer les résidus organiques et les contaminants métalliques.	Résiste aux pH élevés et au stress oxydatif sans lessivage d'impuretés dans le bain.
Gravure à l'acide fluorhydrique	Élimination des couches d'oxyde natif ou des couches de verre sacrificiel des wafers de silicium à l'aide de HF concentré.	Résistance complète au HF, qui dissout le verre ou dégrade les plastiques standard.
Gravure / Décapage Piranha	Élimination de contamination organique importante ou de la photorésine à l'aide d'un mélange d'acide sulfurique et de peroxyde d'hydrogène.	Conserve l'intégrité structurelle aux températures exothermiques élevées générées par les solutions Piranha.
Développement en photolithographie	Immersion des wafers dans des solutions développeuses pour définir les motifs de circuit après exposition UV.	Le rainurage de précision garantit une exposition uniforme de la surface du wafer au fluide développeur.
Rinçage post-CMP	Rinçage de haute pureté après polissage mécano-chimique pour éliminer les particules de slurry.	La surface antiadhésive empêche l'accumulation de slurry et facilite une décontamination rapide et complète.
Fabrication de semi-conducteurs composés	Traitement de wafers GaAs, InP ou SiC pour l'électronique haute fréquence et la fabrication de LED.	La manipulation douce empêche la fracture des matériaux composites plus cassants.
Nettoyage ultrasonique / mégarésonant	Support des wafers pendant le nettoyage acoustique haute fréquence pour déloger les particules submicroniques.	Excellente amortissement des vibrations et stabilité chimique sous les forces de cavitation acoustique.

Catégorie de spécification	Détails des paramètres pour PL-CP166	Options de personnalisation
<b>Matériau principal</b>	PTFE (Polytétrafluoroéthylène) vierge de haute pureté	PFA en option pour une transparence / pureté améliorée
<b>Compatibilité de taille de wafer</b>	4 pouces (100 mm), 6 pouces (150 mm), 8 pouces (200 mm)	Diamètres personnalisés et formes non standard disponibles
<b>Configuration des fentes</b>	Profils de rainure en V ou en U coupés avec précision	Pas, profondeur et espacement angulaire des fentes personnalisés
<b>Capacité</b>	Configurations standard de 25 ou 50 wafers	Tailles de lot sur mesure, d'un wafer unique à haut volume
<b>Conception de la poignée</b>	Poignée intégrée montée sur le dessus ou sur le côté	Poignées amovibles, prolongées ou compatibles avec l'automatisation
<b>Résistance chimique</b>	Spectre complet (Acides, Bases, Solvants, Oxydants)	Vérifiée pour HF, H2SO4, HNO3, HCl, NH4OH, etc.

Application	Description	Avantage clé
Catégorie de spécification	Détails des paramètres pour PL-CP166	Options de personnalisation
Température de fonctionnement	-200°C à +260°C	Adapté à des profils de cycles thermiques spécifiques
Méthode de fabrication	Usinage CNC personnalisé de bout en bout	Contrôle de tolérance de précision pour interface automatisée
Protocole de nettoyage	Lavé en salle blanche et scellé sous vide	Pré-nettoyage spécialisé pour analyse de traces